

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
старшего научного сотрудника
в лаборатории Неравновесных процессов в полупроводниках
Вакансия VAC_36900

Тематика исследований

Фундаментальные исследования в области образования структурных дефектов в полупроводниках под радиационным воздействием различного типа (быстрые электроны, гамма-лучи, протоны, нейтроны), изучение энергетического спектра дефектов кристаллической структуры, влияния радиационных дефектов на электрические параметры полупроводниковых материалов, анализ и моделирование кинетики процессов образования и отжига структурных дефектов радиационного происхождения.

Трудовая деятельность

Непосредственное участие в выполнении исследований согласно гос.заданию и планам НИР по утверждённым целевым программам, а также подготовка и подача заявок на новые проекты в рамках базового бюджетного и целевого финансирования; разработка методов решения наиболее сложных научных проблем; обоснование направлений новых исследований и разработок, предложений к программам и планам научно-исследовательских работ; организация разработки новых научных проектов; координация деятельности соисполнителей работ; обеспечение анализа и обобщения полученных результатов, предложение сферы их применения. Осуществление подготовки научных кадров, участие в повышении их квалификации, а также в подготовке специалистов с высшим образованием в соответствующей области (руководство дипломными и курсовыми работами).

Особенности трудовой деятельности

С целью обеспечения поддержания уровня исследований в лаборатории Неравновесных процессов в полупроводниках на уровне, не ниже достигнутого в настоящее время, при оценке кандидатов комиссия будет исходить из следующих минимальных требований к квалификации кандидатов:

- Ученая степень: кандидат или доктор физико-математических наук.
- Опыт научной и организаторской работы в указанной области: не менее 20 лет.
- За последние 5 лет участие в проектах в рамках Программы фундаментальных научных исследований Президиума РАН.
- Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, в том числе:
 - Полное число публикаций, индексируемых в российской информационно-аналитической системе научного цитирования (РИНЦ): не менее 250 шт. Индекс Хирша: не менее 15.
 - Число публикаций, учтенных в международных информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science или Scopus: не менее 100 шт. за период с 2000 г. по 2018 г.
 - Полное число цитирования публикаций в международных информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science или Scopus: не менее 2000.
- Участие в международных конференциях,
- Практический опыт в организации и проведении хотя бы одной международной конференции по дефектам в полупроводниках.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- личный листок по учету кадров;
- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса;
- характеристика с последнего места работы.

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, заместителю директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе А.Б. Подласкину, телефон для справок: (812)2927196.

Настоящие требования к кандидатам и перечень необходимых документов опубликованы на веб-сайте ФТИ им. А.Ф. Иоффе (<http://www.ioffe.ru>).